

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 品田高宏 副委員長 平野博茂

幹事 池田浩也・諸岡 哲 幹事補佐 森 貴洋・小林伸彰

日時 11月7日(木) 9:55~16:45

8日(金) 9:30~16:40

会場 機械振興会館地下3階2号室(港区芝公園3-5-8, 東京メトロ日比谷線: 神谷町駅から徒歩8分またはJR浜松町駅から徒歩15分)

議題 プロセス・デバイス・回路シミュレーション及び一般

7日午前

1. [招待講演] SISPAD2019 レビュー 鎌倉良成(阪工大)
2. [招待講演] 強誘電体 HfO_2 トンネル接合メモリのスケラビリティに関する検討
○小林正治・莫 非・多川友作・更屋拓哉・平本俊郎(東大)

7日午後(13:10~)

3. [招待講演] 2次元層状トランジスタの界面の理解と制御 長汐晃輔(東大)
4. [招待講演] ビーム実験による原子スケールプロセスにおける表面反応解析
○唐橋一浩・伊藤智子・浜口智志(阪大)
5. [招待講演] Compact Modeling Bridging Industrial Applications Mitiko Miura-Mattausch(Hiroshima Univ.)
6. 3D フラッシュメモリの製造技術を用いた積層型論理回路の設計法—全加算器の設計法, 低消費電力設計法—
○鈴木章矢・渡辺重佳(湘南工科大)

8日午前

1. [招待講演] 強誘電体電界効果トランジスタの動的挙動のデバイスシミュレーション
○服部淳一・池上 努・福田浩一・太田裕之・右田真司・浅井栄大(産総研)
2. [招待講演] 不純物の離散性に伴った半導体デバイスモデリングの基本的側面 II—半導体ナノ構造におけるランダム不純物— 佐野伸行(筑波大)
3. [招待講演] SiC 酸化プロセスの第一原理分子動力学解析 大野隆央(物材機構)

8日午後(13:30~)

4. [招待講演] トレンチゲート型 Si-IGBT の3次元モデリングと精密 TCAD シミュレーション
○渡辺正裕・執行直之・星井拓也・古川和由・角嶋邦之(東工大)・佐藤克己(三菱電機)・末代知子(東芝デバイス&ストレージ)・更屋拓哉・高倉俊彦・伊藤一夫・福井宗利・鈴木慎一・竹内 潔(東大)・宗田伊里也・若林整(東工大)・中島 昭(産総研)・西澤伸一(九大)・筒井一生(東工大)・平本俊郎(東大)・大橋弘通・岩井洋(東工大)
5. [招待講演] 6.5 kV IGBT における飽和電流とテール電流の TCAD キャリブレーションの方法と考察
○諏訪剛史・早瀬茂昭(東芝デバイス&ストレージ)
6. [招待講演] 先進 CMOS イメージセンサ開発へ向けた RTS ノイズの計測・解析技術 黒田理人(東北大)

◆応用物理学会共催

☆SDM 研究会今後の予定

12月24日(火) 奈良先端大 テーマ:半導体材料プロセス・デバイス研究会

【問合先】

野田泰史(パナソニック)

TEL [080] 8442-6837

E-mail: noda.taiji@jp.panasonic.com

鎌倉良成(阪工大)

TEL [072] 866-5381

E-mail: yoshinari.kamakura@oit.ac.jp